

بررسی موجبر جداکننده توان بهینه بلور فوتونیک

تهمینه جلالی¹

۱- استادیار- گروه فیزیک- دانشگاه خلیج فارس- بوشهر- ایران

jalali@pgu.ac.ir

چکیده: در این مقاله، جداکننده توان بلور فوتونیک با اتصال Y شکل به منظور استفاده در ابزارهای مخابراتی طراحی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی شده است. به منظور افزایش میزان عبور موجبر از حفره ای با ضریب شکست متفاوت در محل اتصال استفاده شده است. با استفاده از روش‌های FDTD تعمیم یافته و MMP عبور پرتو از جداکننده توان شبیه‌سازی شده است. با توجه به هندسه موجبر بلور فوتونیک، قطبش الکتریکی عرضی در نظر گرفته شده است. این داده‌ها از تکنیک End-Fire در آزمایشگاه ETH به دست آمده‌اند. انتشار پرتو در جداکننده توان ساخته شده از بلور فوتونیک را بوسیله روش‌های شبیه‌سازی FDTD دوبعدی تصحیح شده و MMP مدلسازی کرده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می‌کنیم. بررسی محاسبات عددی ساختار بهینه نشان می‌دهد نتایج آزمایشگاهی در توافق خوبی با روش‌های FDTD دوبعدی و روش نیمه تحلیلی MMP قرار دارد و میزان عبور به حدود ۴۴/۸٪ در هر شاخه رسیده است.

کلمات کلیدی: بلور فوتونیک، جداکننده توان، روش تفاضل متناهی دامنه زمان، روش چندقطبی چندگانه، شبیه‌سازی، موجبر.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۳/۰۲/۲۶

تاریخ پذیرش مشروط مقاله: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۶/۰۸

نام نویسنده‌ی مسئول: دکتر تهمینه جلالی

نشانی نویسنده‌ی مسئول: ایران - بوشهر - خیابان شهید ماهینی - دانشگاه خلیج فارس - دانشکده‌ی علوم

پیشرفت‌های تکنولوژی در طراحی و تولید قطعات الکترونیکی مینیاتوری و پرسرعت، دانشمندان را بر آن داشت تا فوتون را جایگزین الکترون کنند. این تغییر رویکرد و کاربردهای فراوان ابزارهای اپتوالکترونیک منجر به تولد شاخه‌ای جدید در علم موسوم به فوتونیک گردیده است. در این راستا پژوهش‌های بسیاری بر روی بلورهای فوتونیک به عنوان کاندیدی مناسب جهت ساخت المان‌های فوتونیک معادل با هر المان الکترونیکی، طراحی و ساخت مدارهای مجتمع فوق فشرده فوتونیک انجام شده است [۲۰]. بلورهای فوتونیک ساختارهایی هستند که در بازه‌های بسامدی خاصی، امواج الکترومغناطیسی توانایی عبور (گاف نوری فوتونیک) ندارند [۱]. بلورهای فوتونیک موادی با ساختار تناوبی در یک، دو و سه بعد هستند. در حال حاضر از این ابزار قدرتمند در نمایشگرها، دیودهای نورافشان، سلول‌های خورشیدی، حسگرهای نوری، لیزرهای دیودی و ... استفاده می‌شود. استخراج نور به کمک بلورهای فوتونیک روشی موثر برای افزایش کارایی LEDهای صفحه‌ای است [۴]. کاواک‌های بلور فوتونیک نور را قویا در حجم کوچکی محبوس می‌کنند و در فیزیک و مهندسی کاربردهای بسیاری از جمله، برهم‌کنش بین الکترون و فوتون، اپتیک غیرخطی، پردازش اطلاعات کوانتومی، لیزرهای با آستانه پایین و فیلترهای با دقت بالا، دارند. علاوه بر آن استفاده از تار نوری و لیزرها بر پایه بلورهای فوتونیک در مخابرات مورد توجه بسیار قرار گرفته است [۵]. اخیراً بلورهای فوتونیک مغناطیسی در انتشاردهنده‌های دورانی، ایزولاتورها و مبدل‌های نوری فوق سریع برای پردازش لیزری تصویر نیز به کار برده شده‌اند [۶].

موجبرها و جداکننده‌های توان فوتونیک نقش کلیدی را در ارتباط بین المان‌های فوتونیک به عهده دارند و مجتمع کردن بلورهای فوتونیک در مقیاس بسیار ریز با قرار دادن تعداد بسیاری قطعات فوتونیک را در تراشه میسر می‌سازند [۷-۹]. برای داشتن خمش‌های تیز در موجبرها، تضاد ضریب شکست بالا را لازم داریم. در موجبرهای دی‌الکتریک معمولی، شعاع خمیدگی چندین میلی‌متر است، هرچند در بلور فوتونیک به دلیل جایگزینی نور توسط ساختار تناوبی موجبر اجازه خمش نور را در ابعاد نانو می‌دهد. در میان ابزارهای متنوع بلورهای فوتونیک، جداکننده‌های توان یکی از ابزارهای پرکاربرد با تنوع بسیار است. مقالات بسیاری در زمینه طراحی، ساخت و بهینه‌سازی اتصالات T و Y منتشر شده است [۱۰-۱۶]. اغلب در این ساختارها، از محل انحنای جفت‌شدگی اتصالات اتلاف وجود دارد و تکنیک‌های مختلف بهینه‌سازی به منظور افزایش میزان عبور از شاخه‌ی خروجی وجود دارد. در این جا با قرار دادن حفره‌ای در محل اتصال فضای اتصال Y کاهش می‌یابد و منجر به افزایش عبور می‌گردد.

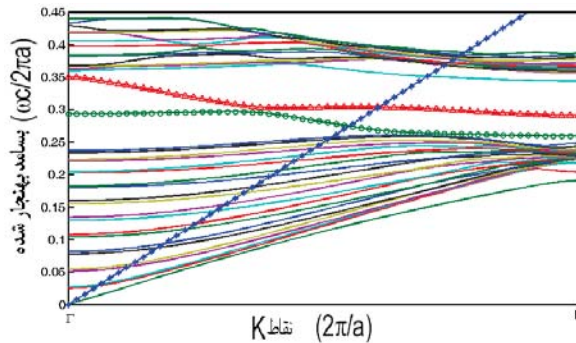
در حوزه تکنولوژی می‌توان هزینه بسیار بالای طراحی و ساخت قطعات

بلورهای فوتونیک را بطور قابل ملاحظه‌ای با شبیه‌سازی و بهینه‌سازی کاهش داد. متأسفانه شبیه‌سازی و بررسی ابزارهای مجتمع فوتونیک چندکاره نیز به واسطه ابعاد بزرگ نسبت به طول موج، نیاز به حافظه زیاد و زمان شبیه‌سازی طولانی دارد. این بزرگترین چالش شناخته شده برای روشهای عددی مرسوم برای محاسبات اپتیکی می‌باشد. برای طراحی المان‌های فوتونیک معمولاً از تکنیک‌های محاسباتی مانند روش تفاضل متناهی بازه زمان (FDTD)، روش چندقطبی چندگانه (MMP)، روش المان متناهی (FEM) و ... استفاده می‌گردد که هر روش معایب و مزایای خود را دارد [۱۹]. روش FDTD تکنیک محاسباتی می‌باشد که در حوزه‌های مختلفی از جمله مهندسی، فیزیک و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. به منظور شبیه‌سازی آنتن‌ها، مدارات الکترونیکی، نانوذرات، ابزارهای بلورهای فوتونی و ... روش FDTD بررسی و استفاده شده است [۸-۱۲]. از مزایای روش FDTD می‌توان به سادگی به هنگام شدن الگوریتم و رفتار قابل کنترل واگرایی با در نظر گرفتن نقاط نمونه فضایی اشاره کرد [۲۰].

در این مقاله، ابزار جداکننده توان بسیار مجتمع با اتصال Y به منظور استفاده در ابزارهای مخابراتی طراحی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی شده است. با استفاده از روش‌های FDTD تعمیم یافته و MMP عبور پرتو از جداکننده توان را شبیه‌سازی کرده و نشان می‌دهیم که نتایج شبیه‌سازی در توافق خوبی با نتایج آزمایشگاه می‌باشد [۳ و ۶]. ساختار این مقاله بدین صورت می‌باشد، ابتدا موجبر بلور فوتونیک معرفی و بهینه‌سازی آن ارائه می‌گردد. سپس روش عددی به طور مختصر توضیح داده می‌شود و نهایتاً نتایج شبیه‌سازی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.

۲- موجبر جداکننده توان بلور فوتونیک

بلورهای فوتونیک دارای نوار ممنوعه‌ای هستند که اجازه انتشار نور در این بازه را نمی‌دهند (شکل ۱). با ایجاد نقص خطی در بلور فوتونیک، نور مجاز به عبور با طول موج‌های مشخص می‌گردد. در بلور فوتونیک دوبعدی نور در راستای عمود بر صفحه بلور به کمک انعکاس داخلی کل جایگزیده می‌گردد. در حالی که جایگزینی در صفحه وابسته به خواص گاف نوری فوتونیک است. ساختار بلور فوتونیک صفحه‌ای شامل لایه‌های عمودی نیمه‌رسانا است که در آن حفره عمیقاً مته‌کاری شده‌اند. مدل‌سازی دوبعدی این ابزارها احتیاج به زمان بسیار کوتا‌تری در قیاس با سه بعدی دارد و برای بهینه‌سازی بلور با تکرار شبیه‌سازی مناسب است. در عمل، به دلیل محدودیت‌های محاسباتی، شبیه‌سازی دوبعدی را به سه‌بعدی ترجیح می‌دهیم. استفاده از جایگزینی ضریب گذردهی از میان موجبر صفحه‌ای در بعد سوم را مورد توجه قرار داده و از گذردهی موثر برای شبیه‌سازی موجبر بره بلور فوتونیک استفاده شده است تا بتوان شبیه‌سازی دو بعدی را به مدل واقعی در سه بعد نزدیک کرد [۱۸].



شکل (۱): ساختار نواری بلور فوتونیک، نوار ممنوعه و مدهای موجبر به وضوح قابل مشاهده هستند

برای ایجاد خمیدگی در ساختار به گونه‌ای که بازتابهای ناخواسته به حداقل برسد، طراحی مناسبی مورد نیاز است که با مدلسازی ساختار و تغییرات مورد نیاز در اتصالات بهینه‌سازی انجام می‌پذیرد. می‌توان با جابجا کردن حفره‌های نزدیک به خمیدگی یا تغییر قطر آنها و یا با اضافه نمودن حفره‌های اختیاری، ساختار را بهینه کنیم. به منظور داشتن گاف نواری ممنوعه پهن در طول موج مخابراتی (۱۵۵۰ نانومتر) فاکتور پرشدگی ۳۴٪ انتخاب شده است و بلور از ماده‌ی $\text{InP}/\text{GaAs}/\text{InP}$ تشکیل یافته است. جداکننده ساختار شش وجهی و خمشی با زاویه‌ی 60° دارد. اندازه کل قسمت جداکننده حدود 5×5 ثابت شبکه است. جداکننده و طیف عبور اتصال بدون هیچ بهینه‌سازی در شکل‌های ۲الف و ۵ آورده شده است که توان عبوری در هر شاخه بسیار پایین است. ناحیه هدایت کننده در حالت اتصال موجبرها پهن تر از موجبر تک مد است. در نتیجه مدها افزایش می‌یابند و در آن ناحیه، چند مدی می‌گردند [۴]. مدهای اصلی و مرتبه بالاتر بطور ویرانگر با یکدیگر در جداکننده غیربهینه تداخل می‌کنند و به خوبی در موجبر هدایت نمی‌شوند (شکل ۳ و ۵). برای کاهش این تداخلها و افزایش عبور باید حجم اپتیکی کاواک در ناحیه‌ی اتصال Y شکل می‌نیم شود، تا مدهای مرتبه‌های بالاتر کاهش یابند. یک حفره کوچک در وسط محل اتصال قرار داده می‌شود. با تغییر اندازه این حفره در محل اتصال می‌توان ماکزیمم عبور در هر شاخه را بدست آورد. این حفره دارای عامل پرشدگی، حدود $14/8$ می‌باشد (شکل‌های ۲ب و ۳). برای افزایش عبور، اندازه حفره باید تغییر کند و با توجه به محدودیت نظری، توان عبور جداکننده در هر شاخه ماکزیمم $4/44$ می‌شود (شکل ۶). در این کار، با توجه به هندسه بلور فوتونیک، قطبش الکتریکی عرضی (TE_x) در نظر گرفته شده است.

۳- محاسبات عددی

ابتدا از روش FDTD برای مدلسازی انتشار پرتو در این موجبر استفاده می‌کنیم. در این روش با شبکه‌بندی فضای محاسباتی و اختصاص خواص اپتیکی مناسب به هر سلول، ساختار مورد مطالعه و میدان‌های برهم‌کنش کننده تعریف می‌گردند [۱۹-۲۱]. در روش FDTD، فضای شبیه‌سازی به سلول‌های مکعبی تقسیم می‌گردد و بر

روی هر سلول مؤلفه‌های میدان الکتریکی و مغناطیسی به ترتیب گذاشته می‌شوند. سپس با استفاده از تفاضل متناهی بر معادلات ماکسول وابسته به زمان، مجموعه‌ی روابط برای محاسبه‌ی مؤلفه‌های مختلف میدان الکترومغناطیسی برحسب مقادیر آنها در زمان قبل به دست می‌آیند. در الگوریتم یی، ابتدا میدان‌های را با استفاده از شرایط اولیه‌ی مقداردهی می‌شوند و سپس در بازه‌ی زمانی مقدار جدید برای هر کدام از مؤلفه‌ها با داشتن میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی مجاور در گام زمانی عقب‌تر به دست می‌آیند. پس از اتمام شبیه‌سازی، با داشتن مقادیر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در تمامی سلول‌ها، می‌توان کمیت‌های فیزیکی مورد نظر را به دست آورد. در روش FDTD برای شبیه‌سازی مسائل با مرزهای باز از شرط مرزی لایه‌ای جاذب ساختگی با عنوان لایه‌ی کاملاً جور شده (PML) استفاده می‌شود، تا بتوان فضای محاسباتی را کوتاه کرد. همچنین با استفاده از PML از انعکاس امواج الکترومغناطیسی به درون ساختار از لبه‌های فضای محاسباتی جلوگیری می‌شود.

با توجه به ساختار بلور فوتونیک، معادلات ماکسول دوبعدی را برای حالت قطبش الکتریکی عرضی در نظر می‌گیریم. فضای شبیه‌سازی به سلول‌های مربعی و زمان نیز با پله‌ی زمانی گسسته تقسیم بندی می‌گردند. سپس تابع را روی مرزهای شبکه در هر پله زمانی نوشته می‌شود. رابطه‌های پله‌ای زمان 2D-FDTD برای مد TE بدین صورت نوشته می‌شود.

$$E_x|_{i,j}^{n+1} = \frac{\epsilon_{i,j} - \sigma_{i,j} \Delta t / 2}{\epsilon_{i,j} + \sigma_{i,j} \Delta t / 2} E_x|_{i,j}^n + \frac{\Delta t}{\epsilon_{i,j} + \sigma_{i,j} \Delta t / 2} \frac{H_z|_{i,j+1}^n - H_z|_{i,j}^n}{\Delta y} \quad (1)$$

$$E_y|_{i,j}^{n+1} = \frac{\epsilon_{i,j} - \sigma_{i,j} \Delta t / 2}{\epsilon_{i,j} + \sigma_{i,j} \Delta t / 2} E_y|_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\epsilon_{i,j} + \sigma_{i,j} \Delta t / 2} \frac{H_z|_{i+1,j}^n - H_z|_{i,j}^n}{\Delta x} \quad (2)$$

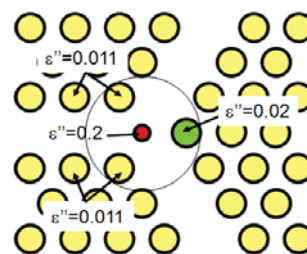
$$H_z|_{i,j}^{n+1/2} = H_z|_{i,j}^{n-1/2} - \frac{\Delta t}{\mu_{i,j}} \left(\frac{E_y|_{i+1,j}^n - E_y|_{i,j}^n}{\Delta x} - \frac{E_x|_{i,j+1}^n - E_x|_{i,j}^n}{\Delta y} \right) \quad (3)$$

که در آن ϵ , μ و σ تراوایی، گذردهی وابسته به مکان و رسانایی ماده هستند. بالانویس n پله‌ی زمان گسسته را نشان می‌دهد و زیرنویس i, j مکان نقاط شبکه در راستای x, y را نمایش می‌دهند. Δt نمو زمان و $\Delta x, \Delta y$ نمو مکان در راستای x, y بین دو نقطه‌ی مجاور شبکه هستند. در این مقاله $\Delta t = 1/c \sqrt{\Delta x^{-2} + \Delta y^{-2}}$ به عنوان پله‌ی زمانی انتخاب شده است، تا شرط پایداری را ارضا کند و c سرعت نور در خلا است. در این کد از شرایط مرزی لایه‌ی جور شده پیشگی $CPML$ استفاده شده است [۱۸]. منبع موجبر با پروفایل زمانی بسته گاوسی $e^{-(t-t_0)^2/2\sigma^2}$ اعمال شده است، که σ پهنای پالس و t_0 زمان تاخیر است. پالس به گونه‌ای انتخاب شده است تا با دامنه‌ی تقریباً صفر شروع شود و پهنای آن گستره‌ی طول موج مورد نظر را بپوشاند.

همچنین از روش چندقطبی چندگانه به منظور مقایسه نتایج مدل‌سازی استفاده شده است. روش MMP روشی نیمه تحلیلی مرزی در بازه بسامد است، که در دهه ۱۹۸۰ توسط هافنر و همکاران توسعه یافت [۲۲]. در این برنامه، تکنیک جفت شدن نقطه تعمیم یافته استفاده شده است. برای داشتن دامنه‌های همگن، فضای محاسباتی به دامنه‌های کوچکتر تقسیم می‌گردد. سپس میدانهای الکترومغناطیسی در هر دامنه با چندقطبی‌ها درون یا بیرون دامنه، بسط داده می‌شوند. با اعمال شرایط مرزی روی مرزهای میان دامنه‌ها ضرایب بسط‌ها محاسبه می‌شود و کمیات فیزیکی را می‌توان با این ضرایب محاسبه می‌گردد [۲۲]. شبیه‌سازی برای هر طول موج به صورت مجزا انجام شده است.

۴- محاسبات و بررسی نتایج

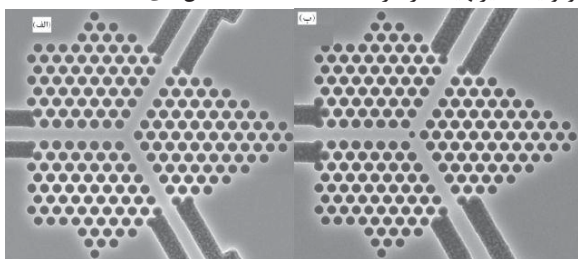
بره در برشی عمودی ساختاری چندلایه دارد: لایه‌ی هدایت InP/GaAs با ضخامت ۴۳۴ نانومتر است، که بین دو لایه ۲۰۰ نانومتری InP احاطه شده است. به منظور داشتن گاف نوار ممنوعه پهن، در طول موج اعمالی ۱۵۵۰ نانومتر و فاکتور پرشدگی ۰.۳۴ انتخاب شده است. ساختار نواری با استفاده از روش بسط موج تخت محاسبه شده است (شکل ۱).



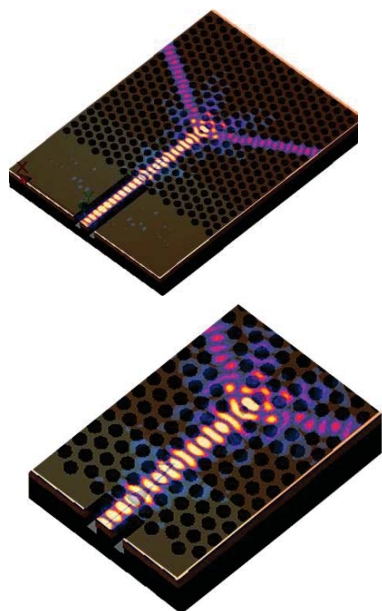
شکل (۲): بهینه‌سازی جداکننده توان با تغییر در اندازه حفره‌ها و تغییر ضریب گذردهی حفره‌ها

به منظور اندازه‌گیری میزان عبور در هر شاخه جداکننده توان از لیزری با توان جداسازی ۱pm در گستره ۱۶۳۰-۱۴۶۵ nm استفاده شده است. توان خروجی لیزر حدود ۱۳dBm که با سرعت ۵۰nm/s گستره‌ی طول موج را پوشش می‌دهد. برای اندازه‌گیری توان خروجی از توان‌سنجی با آشکارسازی با اندازه دهانه ۵mm و جنس GaAs استفاده شده است. حساسیت طول موجی توان‌سنج در گستره‌ی ۱۶۰۰-۸۰۰ nm است [۵]. برای ساخت موجبر در آزمایشگاه از روش Endfire استفاده شده است، برای اطلاعات بیشتر از این روش به مرجع [۸] مراجعه نمایید. به منظور اندازه‌گیری میزان عبور از موجبر بلور فوتونیک در آزمایشگاه از تکنیک (EF) End-fire در گروه فوتونیک مخابراتی دانشگاه ETH استفاده شده است [۱۵]. در آزمایشگاه از منبع نوری با دو لیزر همدوس استفاده شده است. این دو لیزر در گستره‌ی طول موجی ۱۶۳۰-۱۴۷۰ nm کار می‌کنند. تار نوری متمرکز شده به موجبر جفت شده است و لیزرها نور را با قطبش TE

به موجبر تزریق می‌کنند. بعد از انتشار نور از میان موجبر، سیگنال در خارج از موجبر به روش میکروسکوپی گردآوری و با توان‌سنج اندازه‌گیری شده است. فاکتور پرشدگی موجبر توسط دستگاه SEM^۵ اندازه‌گیری شده و در حدود ۳۴/۸٪ تعیین شده است [۱۵]. ابتدا موجبر قبل و بعد از بهینه‌سازی شبیه‌سازی می‌گردد (شکل ۱). پروفایل موج عبوری میدان H_z از موجبر در شکل ۳ قابل مشاهده است. تصویر SEM موجبر جداکننده توان که در دانشگاه ETH بهینه‌سازی و ساخته شده است، در شکل ۲ نشان داده شده است [۹]. میدان H_z موج هدایت شده در موجبر جداکننده توان بلور فوتونیک غیربهینه و بهینه در شکل ۴ آورده شده است، که تداخل‌ها در جداکننده غیربهینه به وضوح مشخص است. توان عبور جداکننده توان بلور فوتونیک غیربهینه در هر شاخه ۴۴٪ می‌شود، در حالی که در جداکننده توان بلور فوتونیک غیربهینه در هر شاخه ۲۸٪ است (شکل‌های ۵، ۶).



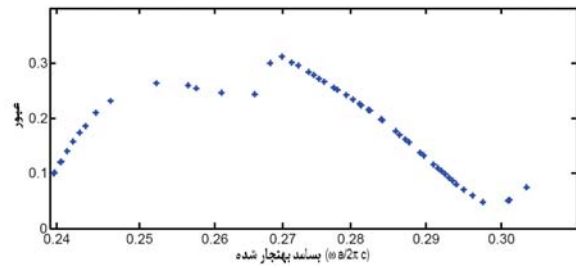
شکل (۳): الف) تصویر SEM موجبر جداکننده توان بلور فوتونیک غیربهینه ب) تصویر SEM موجبر جداکننده توان بلور فوتونیک بهینه



شکل (۴): میدان HZ موج هدایت شده در موجبر جداکننده توان بلور فوتونیک (چپ) غیربهینه و (راست) بهینه

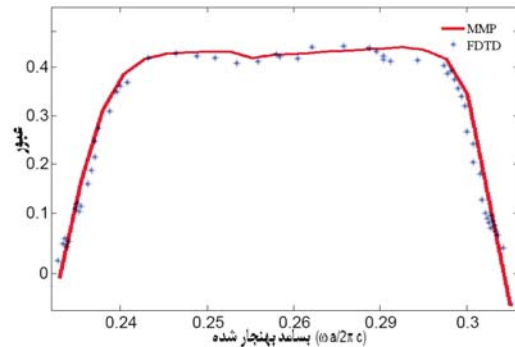
در روش FDTD ابعاد شبکه مربعی، ۴۳/۵nm می‌باشد. ناحیه‌ی شبیه‌سازی در فضای محاسباتی ۳۵۰×۲۰۰ سلول می‌باشد و تعداد لایه‌های CPML برابر ۲۴ انتخاب شده است. چشمه موجبر در وسط

ورودی موجبر اصلی قرار گرفته است و پایین ترین مد TE تولید شده است. شبیه سازی برای بازه زمانی با کامپیوتر شخصی در زمان حدود ۵ ساعت انجام شده است.



شکل (۵): میزان پرتو منتشر شده در هر شاخه جداکننده توان غیربهمینه با روش FDTD

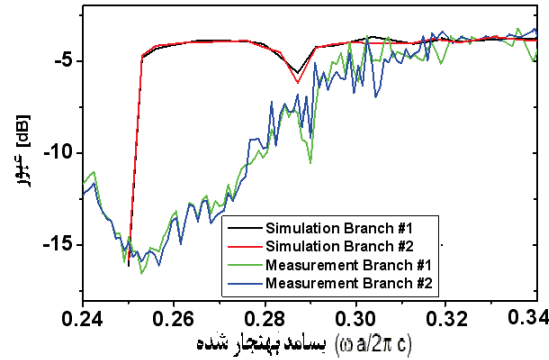
به منظور جفت شدن نور با موجبر بلور فوتونی، از موجبر مدلسازی شده به عنوان تار نوری استفاده می شود (شکل ۳). چندین آشکارساز شار توان در ابتدا و انتهای ساختار متصل شده اند تا انتشار نور را ثبت کنند. لایه های CPML شامل ۸ لایه با میزان انعکاس $1e^{-6}$ می باشند. پهنای نوار عبور در محدوده $0.27 - 0.29$ و قله ی مشخصه آن در بسامد حدود 0.254 می توان مشاهده کرد. در شبیه سازی دوبعدی از ضریب گذردهی موثر و حفره های نامعین استفاده شده است. در ساختار سه بعدی عمق حفره ها حدود $3 \mu m$ در نظر گرفته می شود، همان گونه که در ساختار واقعی در آزمایشگاه وجود دارد.



شکل (۶): میزان پرتو منتشر شده در هر شاخه جداکننده توان بهمینه با دو روش MMP و FDTD

مطابق شکل ۷، نتایج شبیه سازی با اندازه گیری های آزمایشگاهی توافق خوبی دارند. هر دو نشان می دهد توان موج عبوری در هر شاخه یکسان است. پهنای نوار عبوری، ناحیه بسامدی بهنجار شده در آزمایشگاه و شبیه سازی تقریباً مساوی را نشان می دهد. همچنین در بسامدهای کمتر افت توان در اندازه گیری قابل مشاهده است که به دلیل نشت در وسیله ساخته شده می باشد. جایجایی طیف در حدود 0.2 بین نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی قابل مشاهده است. این جایجایی به دلیل میزان تغییرات ایجاد شده از قبیل تغییر فاکتور پرشدگی یا تناوب بلور فوتونیک در هنگام ساخت می باشد. به دلیل این که بره بلور فوتونیک دوبعدی محدود جایگزیدگی نور کاملی را ایجاد

نمی کند، در این دی الکتریک نشت مشاهده می گردد. میزان اتلاف اندازه گیری شده در آزمایشگاه برای این وسیله حدود 10 dB می باشد. با مقایسه نتایج حاضر با مرجع [۲۳] جداکننده توان طراحی شده کوچکتر می باشد و توانسته است مشکل ابعاد بزرگ ساختارهای پیش از این را حل نماید.



شکل (۷): طیف عبوری از دو شاخه جداکننده توان با شبیه سازی و نتایج آزمایشگاهی

۵- نتیجه گیری

در این مقاله، جداکننده توان بلور فوتونیک را طراحی و بهینه سازی نموده ایم و در آزمایشگاه دانشگاه ETH ساخته شده است. از دو روش FDTD و MMP برای شبیه سازی انتشار پرتو نور در جداکننده توان بلور فوتونیک استفاده کرده ایم. هر دو روش توافق خوبی با یکدیگر دارند و نتایج آزمایشگاهی را تایید می کنند. در این جداکننده توان بلور فوتونیک بهمینه با قرار دادن حفره در محل اتصال به میزان عبور بالایی در حدود $44/4\%$ در هر شاخه رسیده ایم. نتایج محاسبات نشانگر این است که می توان قبل از ساخت قطعه بلور فوتونیک آن را شبیه سازی و با تغییر پارامترهای مختلف ساختار مورد مطالعه، طرح بهمینه را بدست آورد.

سپاسگزاری

این کار با پشتیبانی معاونت پژوهشی دانشگاه خلیج فارس انجام شده است. همچنین از همکاری دکتر ارنی و دکتر روشر برای داده های آزمایشگاهی صمیمانه تشکر می کنیم.

مراجع

- [۱] جوناپولوس، جان، مید، رابرت د، وین، جوشا ن، بلورهای فوتونیک قالبی برای شارش نور، ترجمه زرگروشتری، مرتضی، جلالی، تهمینه، مؤسسه انتشارات دانشگاه شهید چمران، ۱۳۸۶.
- [2] Manolatu, C., Johnson, S. G., Fan, S., Villeneuve, P. R., Haus, H. A., Joannopoulos, J. D., "High-density integrated optics J. Lightwave Technol., 17, 1999.
- [3] Mekis, A., Chen, J. C., Kurland, I., Fan, S., Villeneuve, P. R., and Joannopoulos, J. D., "High transmission

- [21] A. Taflov, S. Hagness, "Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method," Artech House, Norwood, MA (2005).
- [22] Ch. Hafner, Post-modern Electromagnetics, John Wiley & Sons, Chichester (1999).
- [23] Rajat Dey, "Optical Power Splitting Techniques Using Photonic Crystal Line Defect Waveguides," Ph.D Thesis, The University of Western Ontario, London, Canada, (2011).

زیر نویس ها

- ¹ Finite Difference Time domain
² Transverse Electric
³ Perfectly Matched Layer
⁴ Convolutional Perfectly Matched Layer
⁵ Scanning Electron Microscope

- [4] Schulz, S. A., O'Faolain, L., Beggs, D. M., White, T. P., Melloni, A. and Krauss, T. F., "Dispersion-engineered slow light in photonic crystals: A comparison," J. Opt. 12(10), 2010.
- [5] Hong-Wei, L. and Qiang, K., "Light Extraction Enhancement of GaN LED with a Two-Dimensional Photonic Crystal Slab," CHIN. PHYS. LETT, 28, 5, 2011.
- [6] Inoue M., Khanikaev A. B. and Baryshev A. V., "Nanomagnetophotonics," Nanoscale magnetic materials and applications. Springer-Verlag, 2009.
- [7] Rauscher, K., Erni, D., Smajic, J. and Hafner, C., "Improved transmission for 60° photonic crystal waveguide bends," Progr. in Electromagne. Research Symp. 43, 25, 2004.
- [8] T. Jalali, A. Mohammadi, "Photonic Crystal Simulation by FDTD Method", Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, (Accepted 2012).
- [9] Strasser, P., Stark, G., Robin, F., Erni, D., Rauscher, K., Wüest, R. and Jäckel, H., "Optimization of a 60° waveguide bend in InP-based 2D planar photonic crystals", J. Opt. Soc. Am. B, 25(1), 2008.
- [10] Ferrini, R., Houdre D. and Qui M., "Radiation losses in planar photonic crystals: two-dimensional representation of hole depth and shape by an imaginary dielectric constant" J. Opt. Soc. Am. B, 20(3), 469-478(2003).
- [11] S. Boscolo, M. Midrio, T.F. Krauss, "Y junctions in photonic crystal channel waveguides: high transmission and impedance matching," Opt. Lett. 27, 1001-1003(2002).
- [12] Sh. Feng, W. Wang and Y. Wang, "Unidirectional Light Beam Splitter Based on the Square-Lattice Photonic Crystal Heterojunctions," Jpn. J. Appl. Phys. 51, 112001(2012).
- [13] Yu Hou, F. Fan, X.-H. Wang, Sh.-J. Chang, "Terahertz power splitter based on ferrite photonic crystal," Optik, 124(22), 5285-5288(2013).
- [14] M. Khatibi Moghaddam, M. M. Mirsalehi, A. R. Attari, "Slow light transmission in a photonic crystal power splitter with parallel outputs," Phot. Nano. Fund. Appl., 12(1), 75-82(2014).
- [15] A. Ghaffari, M. Djavid, F. Monifi and M. S. Abrishamian, "Photonic crystal power splitter and wavelength multi/demultiplexer based on directional coupling," J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 10, 075203(2008).
- [16] M. Djavid, A. Ghaffari, F. Monifi, and M. S. Abrishamian, "Photonic crystal power dividers using L-shaped bend based on ring resonators," J. Opt. Soc. Am. B 25, 1231-1235 (2008).
- [17] S. Boscolo, M. Midrio, C.G. Someda, "Coupling and decoupling of electromagnetic waves in parallel 2D photonic crystal waveguides," IEEE J. Quantum Electron. 38 (1), 47-53(2002).
- [18] تهمینه جلالی، "مدلسازی بره بلور فوتونیک سه بعدی با ثابت گذردهی موثر،" کنفرانس ماده چگال ایران، شیراز، ۱۳۸۹.
- [19] Mohammadi, A., Nadgaran, H. and Agio, M., "Contour-path effective permittivities for the two-dimensional finite-difference time-domain method," Opt. Express 13, 2005.
- [20] Jalali, T., Rauscher, K., Mohammadi, A., Erni, D., Hafner, C., Baechtold, W., Shoushtari, M.Z., "Efficient effective permittivity treatment for the 2D-FDTD simulation of photonic crystals", J. Comput. Theor. Nanosci. 4(3), 2007.